



# 《风光欣》技术资料

\*\*\*\*\*

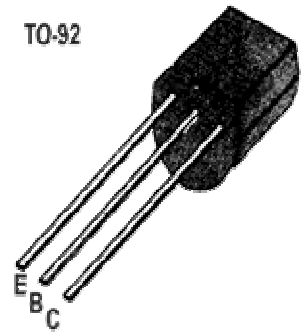
## S 9018

## NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR

主要用途:视频调谐振荡,混频等。

绝对最大额定值 (Ta=25 )

项 目	符号	额定值	单位
集电极-基极电压	V <sub>CBO</sub>	30	V
集电极-发射极电压	V <sub>CEO</sub>	15	V
发射极-基极电压	V <sub>EBO</sub>	5	V
集电极电流	I <sub>c</sub>	50	mA
集电极耗散功率	P <sub>c</sub>	400	mW
结 温	T <sub>J</sub>	150	
存储温度	T <sub>STG</sub>	-55 ~150	



电参数 (Ta=25 )

项 目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	BV <sub>CBO</sub>	I <sub>c</sub> = 100mA, I <sub>E</sub> = 0	30			V
集电极-发射极击穿电压	BV <sub>CEO</sub>	I <sub>c</sub> = 1mA, I <sub>B</sub> = 0	15			V
发射极-基极击穿电压	BV <sub>EBO</sub>	I <sub>E</sub> = 100mA, I <sub>c</sub> = 0	5			V
集电极-基极截止电流	I <sub>CBO</sub>	V <sub>CB</sub> = 12V, I <sub>E</sub> =0			0.05	μA
直流电流增益	h <sub>FE</sub>	V <sub>CE</sub> = 5V, I <sub>c</sub> = 1mA	28	100	198	
集电极-发射极饱和压降	V <sub>CE(sat)</sub>	I <sub>c</sub> = 10mA, I <sub>B</sub> = 1mA			0.5	V
基极-发射极饱和压降	V <sub>BE(sat)</sub>	I <sub>c</sub> = 10mA, I <sub>B</sub> = 1mA			1	V
共基极输出电容	C <sub>OB</sub> f=1MHZ	V <sub>CB</sub> = 10V, I <sub>E</sub> =0,		1.3	1.7	pF
电流增益-带宽乘积	f <sub>T</sub>	V <sub>CE</sub> = 5V, I <sub>c</sub> = 5mA	700	1100		MHZ

Hfe 分档及其标志

分档	D	E	F	G	H	I
HFE	28-45	39-60	54-80	72-108	97-146	132-198